

日程表 (会場別 I)

会場名	収容人数	2018年3月17日(土)		2018年3月18日(日)		2018年3月19日(月)		2018年3月20日(火)	
		午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
A202 (54-202)	121	9:00~11:15 12.6 ナノバイオテクノロジー	13:00~18:30 12.6 ナノバイオテクノロジー	9:00~11:45 12.6 ナノバイオテクノロジー	13:15~18:40 S22 デバイスシミュレーション技術の活用と将来展望	9:00~12:15 10.5 磁場応用	13:15~17:30 S16 磁気科学研究の今と未来		
A204 (54-204)	121	9:00~11:30 チュートリアル (中村 雅一)	13:00~18:00 SP4 「科学技術立国日本」の洞窟危機を救う若手研究者の活躍推進	9:00~11:45 12.3 機能材料・萌芽的デバイス	13:15~18:15 12.3 機能材料・萌芽的デバイス	9:00~11:45 12.3 機能材料・萌芽的デバイス		9:00~11:45 12.3 機能材料・萌芽的デバイス	13:15~15:15 12.3 機能材料・萌芽的デバイス
A302 (54-302)	121			9:30~11:45 3.10 光量子物理・技術	13:30~16:45 S6 量子コンピュータと量子シミュレーションの現状と展望	9:00~11:45 3.10 光量子物理・技術	13:15~19:30 3.4 生体・医用光学	9:00~11:30 3.10 光量子物理・技術	
A304 (54-304)	121		14:00~18:30 2.1 放射線物理一般・検出器基礎	10:00~11:45 2.3 放射線応用・発生装置・新技術	13:15~16:30 S3 真の放射線生体影響解明に向けて進む放射光マイクロビーム評価技術	9:00~11:45 2.3 放射線応用・発生装置・新技術	13:15~15:30 2.3 放射線応用・発生装置・新技術	9:00~12:00 2.2 検出器開発	13:15~16:30 2.2 検出器開発
A402 (54-402)	121	9:00~12:00 3.12 ナノ領域光科学・近接場光学	13:30~18:30 3.12 ナノ領域光科学・近接場光学	9:00~12:00 3.12 ナノ領域光科学・近接場光学	13:15~16:25 S28 複合アミノ化合物による革新的新機能材料の創製		13:30~17:15 3.9 テラヘルツ全般	9:00~12:00 3.9 テラヘルツ全般	13:15~17:00 3.9 テラヘルツ全般
A404 (54-404)	121		13:15~17:00 S3.16 Optics and Photonics English Session		13:15~18:00 S5 高強度レーザーによる物質変換〜材料プロセスの展開	9:00~11:45 3.7 レーザープロセス	13:15~18:45 3.7 レーザープロセス		
B201 (53-201)	95		13:15~17:00 S18 pMAIRS法：非平滑・非晶質薄膜の分子配向を明らかにできる新手法	9:30~11:45 3.15 シリコンフォトニクス	13:15~17:30 3.15 シリコンフォトニクス	9:30~11:45 3.15 シリコンフォトニクス	13:15~19:00 3.3 情報フォトニクス・画像工学		
B203 (53-203)	95	9:30~12:15 3.13 半導体光デバイス	13:15~16:45 3.2 材料・機器光学	9:00~12:00 3.13 半導体光デバイス	13:15~18:00 3.13 半導体光デバイス	9:00~11:45 3.13 半導体光デバイス	13:15~18:30 3.1 光学基礎・光学新領域	9:30~11:30 3.1 光学基礎・光学新領域	
B301 (53-301)	95	9:00~12:15 15.1 ハルク結晶成長	16:00~18:30 15.1 ハルク結晶成長	9:00~12:00 13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション	13:00~15:45 13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション	9:00~12:00 3.6 超高速・高強度レーザー	13:15~19:30 3.6 超高速・高強度レーザー	9:00~12:00 3.6 超高速・高強度レーザー	13:15~16:45 7.1 X線技術
B303 (53-303)	95		16:00~19:15 3.14 光制御デバイス・光ファイバー	9:00~10:15 CS1 [コードシェアセッション] 3.5 レーザー装置・材料 & 3.14 光制御デバイス・光ファイバー 10:30~11:30 3.14 光制御デバイス・光ファイバー	13:15~16:30 11.5 接合、回路作製プロセスおよびデジタル応用	9:00~11:45 1.6 超音波	13:15~18:15 11.4 アナログ応用および関連技術	9:45~12:45 7.2 電子ビーム応用	14:00~16:15 7.2 電子ビーム応用
B401 (53-401)	95		13:00~17:00 S17 超伝導材料を舞台に活躍する数値シミュレーション技術〜物理現象、結晶成長、そしてアプリケーション設計まで〜			9:00~12:00 11.1 基礎物性	13:15~16:00 11.1 基礎物性	10:30~12:00 7.3 微細パターン・微細構造形成技術	13:00~16:15 7.3 微細パターン・微細構造形成技術
B403 (53-403)	95	9:00~11:15 3.5 レーザー装置・材料	13:15~18:00 3.5 レーザー装置・材料		13:15~18:30 11.2 薄膜、厚膜、テープ作製プロセスおよび結晶成長		13:15~16:30 11.3 超伝導、超伝導パワーストック	9:00~11:45 7.5 イオンビーム一般	
C101 (52-101)	164	9:30~12:30 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・配線・MEMS・集積化技術	16:00~17:30 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・配線・MEMS・集積化技術			9:15~11:45 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・配線・MEMS・集積化技術	13:45~19:05 S24 集積化センサシステムによるユビキタス健康管理を目指して	9:15~12:15 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・配線・MEMS・集積化技術	13:45~16:45 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・配線・MEMS・集積化技術
C102 (52-102)	164	9:00~11:30 チュートリアル (高梨 弘毅)	13:45~18:30 S21 多元化合物の新規な物性と応用	9:00~12:00 6.3 酸化物エレクトロニクス	13:45~18:00 6.3 酸化物エレクトロニクス	9:00~12:00 6.3 酸化物エレクトロニクス	13:45~17:45 S12 進展めざましい電子源と最近の新たなアプリケーション	9:00~12:15 6.3 酸化物エレクトロニクス	13:45~16:30 6.3 酸化物エレクトロニクス
C103 (52-103)	164	9:00~11:30 チュートリアル (佐々木 信也・中嶋 健)	13:45~18:00 6.4 薄膜新材料	9:15~11:45 S7 フレキシブルセラミックスコーティング技術と有機・無機ハイブリッドフレキシブルデバイスの新展開	13:30~18:00 S7 フレキシブルセラミックスコーティング技術と有機・無機ハイブリッドフレキシブルデバイスの新展開	9:00~12:15 6.4 薄膜新材料	13:45~17:45 S11 先進3D原子イメージングが拓く新しい材料・デバイス技術	9:00~12:00 6.4 薄膜新材料	
C104 (52-104)	164	9:00~11:30 チュートリアル (栗原 優)	13:45~18:00 SP5 JSAP・SPIE Joint Symposium		13:00~17:00 S9 圧電薄膜の基礎技術と応用デバイス	9:00~12:15 6.1 強誘電体薄膜	13:15~18:30 6.1 強誘電体薄膜		
C201 (52-201)	142		13:15~18:15 8.5 フラズマ現象・新応用・融合分野		13:45~17:30 S10 イオンビームと表面分析：二次イオン質量分析法(SIMS)の最近の進歩と有機分析への応用	9:00~12:00 8.3 フラズマプラズマテクノロジー	13:45~19:00 8.4 フラズマライファイイング		
C202 (52-202)	201	10:00~12:00 17.2 グラフェン	13:45~17:45 17.2 グラフェン	9:00~12:15 17.2 グラフェン	13:45~16:00 17.2 グラフェン		13:45~18:30 17.3 層状物質	10:00~12:15 17.3 層状物質	13:45~15:30 17.3 層状物質
C204 (52-204)	201		13:15~18:30 8.1 プラズマ生成・診断	9:00~10:15 8.6 Plasma Electronics English Session 10:15~10:45 8.5 プラズマ現象・新応用・融合分野 11:00~11:30 8.7 プラズマエレクトロニクス分科内招待講演 11:30~11:45 8.8 プラズマエレクトロニクス賞授賞式	13:45~18:00 S13 二次元シート合成とプラズマプロセス〜超薄膜から原子層まで〜		13:45~18:15 8.2 プラズマ成膜・エッチング・表面処理	9:00~12:15 8.2 プラズマ成膜・エッチング・表面処理	
C301 (52-301)	142				13:45~18:15 CS3 [コードシェアセッション] 3.11 フォトリソグラフィ・現象、13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイス	9:00~11:45 CS2 [コードシェアセッション] 3.11 フォトリソグラフィ・現象、3.12 ナノ領域光科学・近接場光学	13:45~18:30 3.11 フォトリソグラフィ・現象		13:00~16:30 3.11 フォトリソグラフィ・現象
C302 (52-302)	220		13:45~17:30 S26 分野融合で始まる欠陥研究の新時代〜学会を越えた視点から見えてくるもの〜	9:00~12:15 13.7 化合物及びパワー電子デバイス・プロセス技術	13:45~19:00 13.7 化合物及びパワー電子デバイス・プロセス技術	9:00~12:15 13.7 化合物及びパワー電子デバイス・プロセス技術	13:45~18:30 13.7 化合物及びパワー電子デバイス・プロセス技術		
C303 (52-303)	142	10:00~12:00 17.1 カーボンナノチューブ、他のナノカーボン材料	13:45~18:00 17.1 カーボンナノチューブ、他のナノカーボン材料	10:00~12:00 17.1 カーボンナノチューブ、他のナノカーボン材料	13:45~17:30 S4 放射線シミュレーションにおける偏光イメージング技術	9:00~12:15 3.8 光計測技術・機器	13:45~19:00 3.8 光計測技術・機器		13:45~16:45 3.8 光計測技術・機器
C304 (52-304)	220		13:30~17:25 SP3 幸運の前髪を掴む〜女神には前髪がない〜		13:00~17:25 S27 ゲルマニウムの工学〜電子・光・熱・スピン IV族半導体の新展開〜	9:30~11:45 22.1 合同セッション「フォノンエンジニアリング」	13:15~18:50 S32 無機・有機複合材料で放熱問題に挑む〜物理と応用の最前線〜	9:15~11:45 22.1 合同セッション「フォノンエンジニアリング」	12:45~17:00 22.1 合同セッション「フォノンエンジニアリング」

日程表 (会場別Ⅱ)

会場名	収容人数	2018年3月17日(土)		2018年3月18日(日)		2018年3月19日(月)		2018年3月20日(火)	
		午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
D101 (56-101)	240	9:45~11:45 16.3 シリコン系太陽電池	13:00~18:30 S30 テラワット発電に向けて、結晶シリコン太陽電池技術の新たな展開	9:00~11:45 16.3 シリコン系太陽電池	13:15~18:00 16.3 シリコン系太陽電池	9:15~11:45 16.3 シリコン系太陽電池	13:15~18:00 S31 太陽電池分野で活躍する女性達		
D102 (56-102)	240	9:00~11:45 12.4 有機EL・トランジスタ	13:15~18:30 12.4 有機EL・トランジスタ		13:15~19:30 12.4 有機EL・トランジスタ	9:00~11:45 12.4 有機EL・トランジスタ	13:15~16:45 S19 先端計測と機械学習の融合	9:00-12:00 12.4 有機EL・トランジスタ	
D103 (56-103)	240	11:00~12:00 講演奨励賞、Exhibition Award、APEX/JJAP貢献賞贈呈式	17:00~18:45 名誉会員表彰式 業績賞・研究分野業績賞授賞式	9:00~11:45 15.7 結晶評価、不純物・結晶欠陥	13:15~19:30 15.7 結晶評価、不純物・結晶欠陥	9:00~12:15 15.6 IV族系化合物(SiC)	13:30~18:00 15.6 IV族系化合物(SiC)	9:00-12:00 15.6 IV族系化合物(SiC)	13:15~17:00 15.6 IV族系化合物(SiC)
D104 (56-104)	240		13:00~15:30 10.2 スピン基盤技術・萌芽的デバイス技術	9:00~9:45 10.2 スピン基盤技術・萌芽的デバイス技術 10:00~12:00 10.3 スピンデバイス・磁気メモリ・ストレージ技術	13:15~17:00 S15 ニューロモルフハードウェアとはどんなものだろうか？	9:00~12:00 CS6【コードシェアセッション】 10.1 新物質・新機能創成(作製・評価技術)、10.2 スピン基盤技術・萌芽的デバイス技術、10.3 スピンデバイス・磁気メモリ・ストレージ技術	13:00~14:30 CS6【コードシェアセッション】 10.1 新物質・新機能創成(作製・評価技術)、10.2 スピン基盤技術・萌芽的デバイス技術、10.3 スピンデバイス・磁気メモリ・ストレージ技術 14:45~19:00 10.1 新物質・新機能創成(作製・評価技術)	9:00-12:00 10.4 半導体スピントロニクス・超伝導・強相関	13:00~16:00 10.4 半導体スピントロニクス・超伝導・強相関
E201 (57-201)	420		13:15~16:20 S20 化合物電子デバイス・プロセス技術の進展 ~GaAsの繁栄から学ぶ・温故知新~	9:00~12:15 21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」	13:45~17:15 21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」	10:00~11:45 21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」	13:00~17:30 SP7 快適な未来社会を拓く～高分子科学と応用物理学の協奏～	9:00-11:30 21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」	13:00~16:00 21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」
E202 (57-202)	420	9:00~11:45 15.4 III-V族窒化物結晶	13:15~18:30 15.4 III-V族窒化物結晶	9:00~11:45 15.4 III-V族窒化物結晶	13:15~19:30 15.4 III-V族窒化物結晶	9:00~11:45 15.4 III-V族窒化物結晶	13:30~17:30 S29 窒化物半導体特異構造の科学 ~格子欠陥はどこまで制御できるのか：先端評価と機能探索~	9:00-11:45 15.4 III-V族窒化物結晶	
F102 (61-102)	135	9:00~12:15 9.4 熱電変換	13:45~18:30 9.4 熱電変換	10:00~11:45 1.6 超音波	13:45~18:05 S1 熱音響	10:15~12:15 S2 再生可能エネルギーの高度利用に向けた材料・デバイス技術の進展	13:45~17:15 S2 再生可能エネルギーの高度利用に向けた材料・デバイス技術の進展	9:00-12:15 1.4 エネルギー変換・貯蔵・資源・環境	
F104 (61-104)	108		13:45~18:15 12.2 評価・基礎物性	9:00~12:15 12.2 評価・基礎物性	13:30~17:45 S14 IoT時代に向けたナノワイヤデバイス展開とその物理	9:15~12:00 9.2 ナノワイヤ・ナノ粒子	13:30~15:30 9.2 ナノワイヤ・ナノ粒子	9:30-11:30 9.2 ナノワイヤ・ナノ粒子	13:45~16:45 9.1 誘電材料、誘電体
F202 (61-202)	90	9:00~12:15 7.4 量子ビーム界面構造計測	13:45~17:15 9.5 新機能材料・新物性	9:00~11:45 1.3 新技術・複合新領域	13:15~18:30 1.1 応用物理一般・学際領域	9:30~12:15 13.2 探索的材料物性・基礎物性	13:45~18:15 13.2 探索的材料物性・基礎物性	9:15-12:00 1.5 計測技術・計測標準	13:45~16:00 1.5 計測技術・計測標準
F206 (61-206)	108	9:00~12:30 13.3 絶縁膜技術	13:45~18:15 13.3 絶縁膜技術	9:00~11:30 6.2 カーボン系薄膜	13:45~18:00 6.2 カーボン系薄膜	9:00~12:15 6.2 カーボン系薄膜	16:15~19:00 6.2 カーボン系薄膜		
F210 (61-210)	108		13:30~17:15 9.3 ナノエレクトロニクス	9:00~12:30 6.6 フロー顕微鏡	13:45~17:45 S8 チップ増強ラマン散乱(TERS)の最前線	9:45~12:00 CS5【コードシェアセッション】 6.6 フロー顕微鏡、12.2 評価・基礎物性	13:15~17:30 6.6 フロー顕微鏡	9:00-10:30 15.2 II-V族結晶および多元素系結晶	
F214 (61-214)	99		13:45~17:30 15.3 III-V族エピタキシャル結晶、エピタキシーの基礎			9:15~12:15 6.5 表面物理・真空	13:45~17:00 CS4【コードシェアセッション】 6.5 表面物理・真空、7.6 原子・分子線およびビーム関連新技術	9:45-12:00 15.5 IV族結晶、IV-IV族混晶	13:30~15:45 15.5 IV族結晶、IV-IV族混晶
F306 (61-306)	108	9:00~12:15 12.7 医用工学・バイオチップ	13:45~15:30 12.7 医用工学・バイオチップ	9:00~12:15 12.7 医用工学・バイオチップ	13:45~18:30 12.7 医用工学・バイオチップ	9:00~12:15 12.7 医用工学・バイオチップ			
F310 (61-310)	108	9:00~12:00 13.9 化合物太陽電池		9:45~11:45 13.9 化合物太陽電池	13:45~15:30 13.9 化合物太陽電池	9:45~11:45 13.9 化合物太陽電池	13:30~17:30 3.12 ナノ領域光科学・近接場光学		
F314 (61-314)	90		14:00~17:30 13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ電子デバイス						
G201 (63-201)	312		12:58~17:46 SP1 クラウドとIoTエッジの相乗作用によるスマート社会へのロードマップ～コンピュータサイエンスと半導体物理の複眼視点からの未来予測～		13:00~18:30 SP6 集積化MEMSの発展と展望(集積化MEMS技術研究会発足10周年記念シンポジウム)	10:00~12:00 SP8 AI・IoT・ビッグデータで爆発的に拡大する半導体産業を支える日本の技術～若手社員の現場の声ととも～	13:15~17:35 S25 日本の半導体産業・研究の明るい未来を描く		
G202 (63-202)	312	9:00~11:15 12.5 有機太陽電池	12:45~18:45 12.5 有機太陽電池	9:00~12:15 12.5 有機太陽電池	16:00~18:30 12.5 有機太陽電池	9:00~11:15 12.5 有機太陽電池	13:15~16:30 12.2 評価・基礎物性	9:00-11:45 12.5 有機太陽電池	
G203 (63-203)	100		13:15~18:00 SP2 物質と宇宙の基礎研究とそれがもたらす最先端産業技術	9:00~12:15 13.5 デバイス/集積化技術	13:15~18:00 13.5 デバイス/集積化技術	9:00~12:00 13.5 デバイス/集積化技術	13:30~17:10 S23 グルマニウムはシリコンを代替するの？	9:00-11:45 16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス	13:15~15:30 16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス
G204 (63-204)	100			9:30~11:30 13.8 光物性・発光デバイス	13:15~17:30 13.8 光物性・発光デバイス	9:00~11:45 13.8 光物性・発光デバイス	13:15~15:15 13.8 光物性・発光デバイス	9:45-11:45 13.8 光物性・発光デバイス	13:45~15:00 16.2 エナジーハーベスティング
G205 (63-205)	100			9:00~11:30 12.1 作製・構造制御	13:15~18:00 12.1 作製・構造制御	9:00~11:30 12.1 作製・構造制御			
ベルサール高田馬場(P1~P20)	ポスターセッション		[13:30-15:30] 1.1 応用物理一般・学際領域 1.3 新技術・複合新領域 3.13 半導体デバイス 3.14 光制御デバイス・光ファイバー 6.6 フロー顕微鏡 12.3 機能材料・萌芽的デバイス 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・配線・MEMS・集積化技術 13.5 デバイス/集積化技術 15.1 バルク結晶成長	[9:30-11:30] 1.2 教育 3.2 材料・機器光学 7 ビーム応用 9.3 ナノエレクトロニクス 9.5 新機能材料・新物性 11 超伝導 12.4 有機EL・トランジスタ形成技術 13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ電子デバイス	[13:30-15:30] 3.5 レーザ装置・材料 6.5 表面物理・真空 9.4 熱電変換 12.5 有機太陽電池 12.6 ナノバイオテクノロジー 13.2 探索的材料物性・基礎物性 13.3 絶縁膜技術 15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎	[16:00-18:00] 3.12 ナノ領域光科学・近接場光学 3.16 Optics and Photonics English Session 12.2 評価・基礎物性 13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション 13.9 化合物太陽電池 15.6 IV族系化合物(SiC) 22.1 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」	[13:30-15:30] 1.5 計測技術・計測標準 1.6 超音波 3.10 量子物理・技術 6.3 酸化物エレクトロニクス 6.4 薄膜新材料 6.2 カーボン系薄膜	[9:30-11:30] 3.7 レーザプロセス 3.8 光計測技術・機器 3.11 フォトニック構造・現象 3.15 シリコンフォトニクス 6.1 強誘電体薄膜 9.1 誘電材料・誘電体 12.1 作製・構造制御 16.2 エナジーハーベスティング 16.3 シリコン系太陽電池	[13:30-15:30] 3.1 光学基礎・光学新領域 3.4 生体・医用光学 3.6 超高速・高強度レーザー 8 フラズマエレクトロニクス 15.2 II-V族結晶および多元素系結晶 15.4 III-V族窒化物結晶